https://doi.org/10.12442/j.issn.1002-185X.20240628

AIN 陶瓷与 AI 低温钎焊钎料设计及接头组织性能研究

周航泽1,3,龙飞2,徐瑞1,3,王策1,3,何鹏1,3,施清清4,赵岩5

(1. 哈尔滨工业大学 郑州研究院,河南 郑州 450018)
(2. 河南省科学院材料研究所,河南 郑州 450046)
(3. 哈尔滨工业大学 材料结构精密焊接与连接全国重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150001)
(4. 格力电器(郑州)有限公司,河南 郑州 450066)
(5. 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司,河南 南阳 473000)

摘 要:针对目前缺乏适合AIN陶瓷和AI低温钎焊的钎料的问题,通过向AgCuTi 钎料中加入In和Sn元素来降低 钎料熔点,制备了新型低温钎料Ag-28Cu-35In-2Ti和Sn-19Ag-14.35Cu-17.5In-1Ti(质量分数),从而实现AIN/AI接头的良好连接。探究了两种钎料对AIN陶瓷和AI的低温钎焊工艺和接头组织形貌及性能影响。结果表明:Sn-19Ag-14.35Cu-17.5In-1Ti钎料在钎缝处形成了InSn₃、TiAl₃等相对稳定的化合物。Ag-28Cu-35In-2Ti钎料在钎缝处生成Al₂Cu、AgIn₂和TiAl₃等相对稳定的化合物,随着焊接温度的增加,接头强度随之提高。为阻止In的扩散析出,选择在AI表面镀Ni,但镀Ni使接头导热性能有所下降。发现使用Ag-28Cu-35In-2Ti钎料进行焊接,在640℃保温30min的条件下,接头强度最高,为20.28MPa;在620℃保温15min的条件下,热扩散系数可达到65.941m²/s。该钎料为AIN陶瓷/AI的高可靠连接提供了一种新的方法。 关键词:低温钎料;AIN/AI;组织性能;表面改性

大键问: 瓜血打科; AIN/AI; 组织住肥; 衣面以

中图法分类号: TG454 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2025)02-0453-10

随着智能化、信息化时代到来,航空航天、军工国防、 轨道交通等领域电子设备向尺寸小型化、功能一体化、高 功率密度化方向迅猛发展,同时由超高热流密度引发的 热控问题也日益凸显^[1-2]。对于电子器件而言,通常温度 每升高10℃,器件有效寿命就降低30%~50%。若热量 不能及时散失,温度过高会导致芯片与基板间产生热应 力及热疲劳甚至会直接烧毁器件。故在此基础上,对功 率半导体器件进行科学的封装显得尤为重要^[3]。

对于功率半导体器件而言,封装基板必须满足 以下要求:(1)高热导率。由于器件产生的热量大部 分经封装基板传播,所以导热良好的基板可使芯片 免受热破坏。(2)与芯片材料热膨胀系数匹配。由于 芯片直接贴装于封装基板上,两者热膨胀系数匹配 会降低芯片热应力,提高器件可靠性。(3)耐热性好, 满足功率器件高温使用需求,具有良好的热稳定性, 以及绝缘性好、机械强度高、价格适宜等要求^[4-7]。 由高导热 AIN 陶瓷与 AI 连接而成的覆铝陶瓷基板因 其优异的散热性能,优良的抗热震疲劳性能,良好的 热稳定性,轻质与良好的 AI 线键合能力成为新一代 封装基板首选材料之一^[8-12]。目前我国对此基板的 制造技术及其内在机理等尚处于探索阶段,所以开 展 AIN 与 AI 高强度、高导热、高可靠连接及相关理论研究迫在眉睫。

由于AIN与AI材料性能差异,实现二者的可靠连接存 在以下难题:(1)因AI氧化膜存在,会影响接头焊接质量; (2)AIN性能稳定,润湿性差,导致目前缺乏合适的连接材 料和方法;(3)AIN与AI热膨胀系数差异大,界面残余应力 高;(4)通过预氧化法、活性钎焊法等制造的接头存在Al₂O₃ 等高热阻界面产物,导致接头热导率低。(5)研究集中于工 艺探索和接头强度方面,接头界面结合特性尚不清晰^[13-18]。

由于AlN陶瓷表面性质稳定,润湿性差,通过测试 Al、Sn、In等14种金属钎料以及向其中加入Cr、Ni、Ti等 活性元素的合金钎料在AlN表面的润湿性,结果表明在 不加活性元素的条件下,只有Al和Si在AlN表面润湿, 而在活性元素中,只有Ti元素可以起到提高钎料润湿性 的作用^[19-23],所以,在目前广泛应用在陶瓷钎焊中的Ag-Cu系活性钎料中,只有AgCuTi钎料适用于AlN陶瓷的 钎焊^[24-28]。但AgCuTi钎料的焊接温度普遍在800℃以 上,高于Al的熔点(660℃),不符合Al的焊接要求。所 以目前缺乏适合AlN陶瓷和Al低温钎焊的钎料。而目 前通常采用向钎料中加入In或Sn等降熔元素的方法对 钎料降熔,若向AgCuTi钎料中加入In或Sn等降熔元素,

收稿日期:2024-09-29

作者简介:周航泽,男,2000年生,硕士,哈尔滨工业大学郑州研究院,河南郑州 450018,E-mail: 13689798625@163.com

基金项目:中国博士后科学基金(2023M7408938);国家自然科学基金(52305353)

有可能使钎料熔点降低至Al熔点以下,满足AlN陶瓷和Al钎焊的温度要求。

综上,针对目前功率半导体器件对于散热基板的迫 切需求,本研究设计新型低温钎料,对AIN陶瓷和AI低 温钎焊以及接头组织性能调控进行研究,通过设计低温 钎料,一体化制备AIN和AI高导热高强度连接接头,有 望开发出高可靠、高导热、高强度的新一代陶瓷散热基 板。本研究将对AIN陶瓷和AI连接及其它陶瓷基板的 连接提供新思路。

1 实 验

实验所用的 AIN 陶瓷基板尺寸为 114.3 mm× 114.3 mm×3 mm,在AIN 陶瓷中含有 2%~5%(质量分数) 的 Y₂O₃烧结剂。AI 板尺寸为 100 mm×100 mm×5 mm。 为方便后期钎焊需要,将AIN 陶瓷及Cu板分别用金刚石 切割及电火花线切割方式进行规格重置,尺寸规格分别 为3.5 mm×3.5 mm×3 mm和7 mm×7 mm×5 mm。

制备钎料所采用的原材料:Ag-32.56Cu-22.12In-2.27Ti(In22)四元合金粉;Sn-3Ag-0.7Cu(SnAgCu)三元 合金粉和In粉。通过XGB2行星式球磨机向钎料中混入 In粉来制备新钎料,将钎料称量20g,倒入球磨罐中,并 且在球磨罐中倒入无水乙醇和磨球,同时磨球:钎料:无 水乙醇溶液的质量比为2:1:1,且大球:小球的质量比为1: 1。将球磨罐放入球磨机紧固后,以转数200 r/min,球磨 时间1.5h开始球磨^[29-31]。球磨完成后,将得到的钎料放 入真空干燥箱中保存。通过上述方法,分别得到Ag-29.3Cu-30In-2.1Ti(In30),Ag-28.3Cu-32In-2.04Ti(In32), Ag-28Cu-35In-2Ti(In35)和Sn-19Ag-14.35Cu-17.5In-1Ti (SnAgCuInTi)4种钎料粉末。

通过 XRD 分析钎料的物相组成,通过 TG/DSC 同步 热分析仪测定钎料的熔点,通过动态润湿角测量仪测定 制得钎料的润湿角,设置温度曲线,即在 20 min 内从 0 ℃ 升温到 200 ℃,在 200 ℃时保温 10 min;在 20 min 内从 200 ℃升温到 400 ℃,在 400 ℃ 时保温 10 min;在 40 min 内从 400 ℃升温到 600 ℃,在 600 ℃时保温 20 min;在 40



min内从600 ℃升温到800 ℃,在800 ℃时保温20 min, 加热曲线如图1所示。通过计算机观察润湿角的实时变 化,确定润湿时间和温度。

钎焊试样如图2所示,钎焊过程在真空钎焊炉中进行,钎焊设备可以提供的极限真空度为1×10⁴ Pa、最高加热温度为700℃,升温速率范围在5~10℃/min。焊接温度在580~640℃,保温时间在15~30 min,在钎焊过程中,炉腔内的真空度一般保持在5.0×10³ Pa以下。

焊接成功后,首先使用牙托粉对焊接试样进行冷镶 固定,然后依次使用 80#、240#、400#、800#、1500#和 2000#砂纸进行打磨处理后,在精密研磨抛光机上借助 0.5 µm的Al₂O₃抛光剂完成对金相试样的抛光处理,使用 SU5000场发射扫描电子显微镜(SEM)及其附属的 UltimMax40型X射线能量分散谱观察钎焊接头的组织 并分析钎缝的成分,使用X射线衍射仪进一步确定钎焊 完成后接头内部的反应相构成,与EDS结果进行验证, 钎焊接头的剪切强度采用电子万能试验机进行测试,抗 剪实验示意图如图3所示。

采用 TG/DSC 同步热分析仪测量接头的热扩散系数。为测量接头的热扩散系数,首先使用游标卡尺测量接头的厚度。而后使用阿基米德排水法测量接头的密度。通过热扩散系数的测量来分析接头的导热性能。



图2 钎焊试样制备示意图 Fig.2 Preparation diagram of brazed specimen



图 3 抗剪实验示意图 Fig.3 Schematic diagram of the shear resistance test

2 结果与讨论

2.1 低温钎料的成分设计与制备

2.1.1 低温钎料的成分设计

目前,由于在活性元素中只有Ti可以改善AIN陶瓷的润湿性,而活性钎焊法主要应用的AgCuTi体系钎料的钎焊温度较高,在800℃以上,而AI熔点为660℃。 所以,为得到符合AIN陶瓷/AI钎焊温度要求的钎料,根 据文献以及Ag-Cu-In与Sn-Cu-Ag的三元相图^[32-33]向钎 料中混入降熔元素In、Sn,即通过固定Ag和Cu的含量 加入In、Sn元素,使其成分点到达三者共晶点,从而降 低钎料的熔点。根据相图可知,In的含量在30%~35% 时可达到Ag、Cu、In三者共晶点,使混合后的钎料更均 一,性能稳定。所以钎料中In的质量分数应在30%~ 35%之间。

2.1.2 低温钎料的制备与性能研究

能否获得良好的 AIN/AI 钎焊接头的关键在于钎料 对于 AIN 陶瓷的润湿性以及钎料熔点是否满足 AI 钎焊 的要求。因此在连接过程中,钎料中降熔元素 In 的添加 量以及钎料的制备方法尤为重要,本节探讨钎料的成分 制备以得到润湿良好的接头。

图 4 为不同 In 含量钎料与 AIN 陶瓷的润湿情况, 其中图 4a 是购买所得的 In 质量分数为 22%的 AgCuInTi 钎料,图 4b~4d分别是用研钵充分研磨的 In 质量分数为 30%,32%和 35%的 AgCuInTi 钎料。可以 看出,购买的商用 AgCuInTi 钎料在 710 ℃出现熔化迹 象,润湿情况较差。In 质量分数为 30% 的钎料润湿情 况改善不明显。但接着随着 In 含量的增加,钎料熔点 明显下降,润湿情况有明显改善。如图 4c~4d 所示, In 质量分数为 32% 的钎料在 680 ℃左右开始熔化,在 700~720 ℃时润湿角变小速率明显增加,在 740 ℃时 润湿角可达 44.487°。In 质量分数为 35% 的钎料在 640 ℃左右开始熔化,在 640~700 ℃时润湿角迅速变 小,在 760 ℃时润湿角可达 33.4°。可以看出, In 质量 分数 35% 的钎料润湿情况最好。

图 5 为 In 质量分数为 35%的 AgCuInTi 钎料在球磨 不同时间情况下与 AIN 陶瓷的润湿情况。图 5a 是用研 钵充分研磨的钎料,图 5b~5d 分别是球磨时间为 30,60 和 90 min 的钎料。随着球磨时间的增加,钎料熔点明显 下降,润湿情况有明显改善。未经球磨的钎料在 640 ℃ 左右开始熔化,在 640~700 ℃钎料熔化速率较快,在 760 ℃时润湿角可达 33.4°。如图 5b~5d 所示,经过 30 min 球磨后的钎料在 590 ℃开始熔化,在 590~620 ℃润 湿角迅速减小,在 690 ℃润湿角可达到 19.0°。经过 60 min 球磨后的钎料在 590 ℃开始熔化,在开始阶段钎料 熔化速率较慢,在 620 ℃钎料熔化速率增加,在 690 ℃润 湿角可达 16.8°,经过 90 min 球磨后的钎料在 570 ℃开始 熔化,融化速率比较均匀,在 690 ℃润湿角可达 15.2°。 可以看出,随着球磨时间增加,钎料的熔点下降,润湿情 况逐渐变好。



Fig.4 Wettabitity of AlN with brazing metal with different In contents: (a) 22%, (b) 30%, (c) 32%, and (d) 35%



图 5 球磨不同时间钎料对 AlN 润湿情况

Fig.5 Wettability of AlN with brazing metal ball milled for different time: (a) mortar, (b) 30 min, (c) 60 min, and (d) 90 min

所以,从图4和图5和可以看出,随着钎料中In含量 的增加以及在制备钎料的过程中球磨时间的延长,钎料 的熔化温度逐渐下降,钎料对石墨的润湿情况得到改善。 从图6可以看出,随着球磨时间的增加,界面处气孔随之 减少,界面情况得到改善。所以,钎料中 In 含量的增加 和球磨时间的延长会使得焊接接头质量得到提升。

对含 In 质量分数为22% 的钎料和含 In 质量分数为35% 的 AgCuInTi 钎料分别球磨 90 min,并将混粉所得含



图6 球磨不同时间In35钎料钎焊接头OM照片

Fig.6 OM images of brazed joints with In35 brazing metal ball milled for different time: (a) mortar, (b) 30 min, (c) 60 min and (d) 90 min

第54卷

In质量分数为35%AgCuInTi钎料与购买所得 SnAgCu钎 料按照1:1的比例进行球磨混合,对所得的3种钎料进行 XRD与DSC测量,进行对比分析,如图7和图8所示。

图7a为含In质量分数为22%的AgCuInTi钎料粉末 XRD图谱,由于在制作粉末过程中,经历了压片,加热等 操作,使图像呈现非晶形态的馒头峰,同时,In与Ag,Cu 反应,反应产物为Ag,In4,Cu,In4析出。图7b为含In质量 分数为35%的AgCuInTi钎料粉末XRD图谱。可以看 出,加入的In没有完全与原钎料合金化,其中部分In在 粉末中以单质的形式存在,同时In与原钎料中的Cu发生 反应并析出了Cu7In3。图7c为将混粉所得含In质量分数 为35%的AgCuInTi钎料与SnAgCu钎料按照1:1的比例 进行球磨混合所得的钎料 Sn-19Ag-14.35Cu-17.5In-1Ti (SnAgCu-InTi),可以看出,钎料中有 Sn 析出,加入的 In 没有完全与原钎料合金化,部分 Sn 与 In 以单质的形式在 钎料中存在。同时,少量 Sn 与钎料中的 Cu 发生反应并 析出了 Cu,Sn。

从图 8 可以看出,加入 In 粉后钎料的固液相转变温 度明显下降,含 In 量 22%的钎料熔化温度为610℃,含 In 量 35%的钎料熔化温度为559℃。向钎料中加入 In 后, 钎料熔化温度明显下降,所制得的钎料符合 Al 低温钎焊 的要求。而 SnAgCu 钎料熔化温度为237℃,将 SnAgCu 钎料与 AgCuInTi 钎料混合同样可以起到降低钎料熔化 温度的作用,新制得钎料熔化温度为487℃。



Fig.7 XRD patterns of solder powder: (a) In22, (b) In35, and (c) SnAgCuInTi



Fig.8 DSC curves of solder powder: (a) In22, (b) In35, (c) SnAgCu brazing meterial, and (d) SnAgCuInTi

2.2 AIN/AI 低温钎焊连接及接头组织性能

使用含 In 质量分数为 35% 的 AgCuInTi 钎料对 Al 和 AlN 在 620 ℃,保温 30 min 的条件下钎焊,焊后试样 进行磨抛处理,处理后试样的 SEM 照片和元素面分布 如图 9~10 所示。可以看出,焊接过程中有 AgIn₂,TiAl₃ 和 Al₂Cu 等相对均匀的化合物生成,钎料中 Ag、Cu 以及 In 元素向母材发生扩散,Ag 与 Cu 固溶在 Al 中,而 In 沿 Al 的晶界析出。

使用SnAgCu与In35混合钎料对Al和AlN在620℃,保 温20min的条件下钎焊,焊后试样进行磨 抛处理,处理 后试样的SEM照片和元素面分布如图11、图12所示。 可以看出,焊接过程中Ag、Cu、In、Sn元素向母材发生扩 散,Ag与Cu固溶在Al中,而In和Sn析出反应生成 InSn₃,同时在界面处Ti与Al反应生成TiAl₃。对接头的 力学性能测量后,发现接头剪切强度较低,仅有1MPa左 右。所以,在之后的实验中选择AgCuInTi钎料来探究钎 焊温度对接头性能的影响。

选择 In 含量 35%的 AgCuInTi 钎料,研究连接过程 中钎焊温度对接头组织和力学性能的影响,固定其他钎 焊过程参数,保温时间为 30 min,钎焊温度分别为 580、 600、620 以及 640 ℃,所得钎焊接头如图 13 所示。

从图 13 中可以看出,当保温时间保持 30 min 不变时,随着钎焊温度升高,钎料逐渐反应完全。当钎焊温度为580 ℃时,在钎缝处还有未反应完全的钎料残留,同时



图 9 In35 钎料 620 ℃保温 30 min 焊缝不同放大倍数 SEM 照片 Fig.9 SEM images of the welded seam with In35 brazing metal held at 620 °C for 30 min



图 10 图 9a 对应 EDS 面扫描 Fig.10 Element mappings corresponding to Fig.9a: (a) Al, (b) Ag, (c) N, (d) In, (e) Ti, and (f) Cu



图 11 SnAgCuInTi 钎料 620 ℃保温 20 min 焊缝不同放大倍数 SEM 照片 Fig.11 SEM images of weld seam with SnAgCuInTi brazing metal held at 620 °C for 20 min



图 12 SnAgCuInTi 钎料 620 °C 保温 20 min 接头 EDS 面扫描

Fig.12 Element mappings (a) of joint with SnAgCuInTi brazing metal held at 620 °C for 20 min: (b) Sn, (c) Ti, (d) Cu, (e) Al, (f) Ag, (g) N, and (h) In



图 13 In35 钎料不同连接温度下的接头组织

Fig.13 Microstructures of joints with In35 brazing metal at different connection temperatures: (a) 580 °C, (b) 600 °C, (c) 620 °C, and (d) 640 °C

在靠近铝侧有 Ag-Cu 固溶体生成。当温度逐渐升高后, 钎料反应完全,在钎缝处有 Al₂Cu 和 AgIn₂生成,同时有 TiAl₃生成以及N的析出。当温度到640 ℃时,在钎缝处 有少量 AgIn₂和大量 TiAl₃生成。

图 14 是在保温时间 30 min 不变时,选用不同的连接 温度焊接所获得的 AlN 陶瓷和 Al 的焊接接头的室温抗 剪强度。如图 14 所示,当保温时间为 30 min 不变时,随 着钎焊温度的升高,接头的室温抗剪强度逐渐升高,并在 焊接温度 640 ℃时达到最大值 20.28 MPa。由此可见,焊 接温度的升高使得钎料逐渐反应完全,对接头的室温抗 剪强度起到了增强作用。

对 620 ℃下保温 30 min 的接头断口进行 XRD 分析,如 图 15 所示。可以看出,接头断裂位置处的相以 In、AgIn₂、 Al₂Cu等析出相,反应相为主,说明断裂位置在反应界面处。 说明钎焊界面是焊接接头的薄弱位置。

2.3 基于 AI 表面改性对 AIN/AI 低温钎焊连接及接头 组织性能影响

可以看出,在焊接过程中,In的析出是一个普遍的现





Fig. 14 Room temperature shear strength of In35 brazed joints at different brazing temperatures

象,对接头的导热和力学性能产生一定的影响。为改善In的扩散情况,选择在Al表面镀Ni层^[34]。

通过磁控溅射的方式在Al表面镀Ni层,在磁控 溅射前,对Al表面进行磨抛处理,保持Al表面清 洁,磁控溅射时间为2h。而后在620℃保温15min 的情况下进行焊接,并与不镀Ni所得的焊接接头进 行对比。如图16、图17所示。可以看出,镀Ni后所 得接头在钎缝处有AgIn₂生成,仍有少量In析出,但



图 15 620 ℃保温 30 min 下 In35 钎焊接头断口 XRD 图谱

Fig.15 XRD pattern of In35 brazing joint held at 620 °C for 20 min

由于Al与Ni反应生成Al₃Ni,呈带状分布在Al中, 有效阻止了In向Al侧的扩散,使得In的析出主要存 在于焊接界面处。

对焊接接头的热扩散系数进行测量,同时与母材对 比如图18所示。可以看出,虽然在Al表面镀 Ni有效阻 止了In的扩散,但由于Al与Ni反应生成Al₃Ni,使接头的 导热性能下降,热扩散系数仅达到21.452 m²/s,为不镀 Ni 接头65.941 m²/s的1/3。



图 16 620 ℃保温15 min镀Ni焊缝不同放大倍数SEM照片 Fig.16 SEM images of Ni plating weld held at 620 °C for 15 min



图 17 不镀 Ni 焊缝不同放大倍数 SEM 照片 Fig.17 SEM images of non-Ni plating weld



Fig.18 Thermal diffusivity of the joint

3 结论

1)通过AgCuInTi钎料中加入不同质量分数的In降低钎料熔点,改善钎料润湿性。并探究了球磨时间对钎料的影响,发现当In含量到达35%,球磨时间为90 min时,钎料的熔点最低,且润湿角低,在570℃发生熔化,润湿角在690℃仅为15.2°,润湿性良好。通过将含35%In的AgCuInTi钎料与SnAgCu钎料1:1混合得Sn-19Ag-14.35Cu-17.5In-1Ti钎料在487℃发生熔化。

2)使用 Ag-28Cu-35In-2Ti 钎料所得接头是由 Al₂Cu, AgIn₂, TiAl₃, In以及Al基固溶体所组成。使用的 Sn-19Ag-14.35Cu-17.5In-1Ti 钎料所得接头是由 InSn₃, Al₃Ti 以及Al基固溶体所组成。

3)使用 Ag-28Cu-35In-2Ti 钎料所得接头的抗剪切强 度随温度升高呈现上升趋势,随着温度升高,钎料逐渐 反应完全,In 析出量减少,接头强度升高。

4)Al表面镀Ni可以有效阻止In的扩散,但接头热扩散系数仅为21.452 m²/s,而不镀Ni的接头热扩散系数可达到 65.941 m²/s,Al 表面镀Ni 使接头导热性能明显下降。

5)使用 Ag-28Cu-35In-2Ti 钎料进行焊接,在焊接温度为640 ℃,保温时间为30 min 的条件下,所得的焊接接头抗剪切强度最高,为20.28 MPa。

参考文献 References

- Lin Jincheng, Xiao Bangyang, Xing Lili et al. Journal of the European Ceramic Society[J], 2022, 42(9): 3708
- [2] Wang Yifeng, Jin Zhouxin, Feng Guangjie *et al. Crystals*[J], 2022, 12(7): 933
- [3] Zhang Jiayou, Mo Yiming. Chemical Engineering Journal[J], 2022, 435: 134889
- [4] Cheng Hao(程浩), Chen Mingxiang(陈明祥), Luo Xiaobing(罗小兵) et al. Advanced Ceramics(现代技术陶瓷)[J], 2019, 40 (4): 265
- [5] Ning Pingfan, Liu Jie, Wang Didi et al. IEEE Access[J], 2021, 9:

12074

- [6] Li Shishuai, Chen Huanbei, Wang Heide et al. International Journal of Applied Ceramic Technology[J], 2022, 19(5): 2873
- [7] Ethireddy R, Samuel T, Pamu D. Ceramics International[J], 2022, 48(19): 29372
- [8] Mu Guoqian, Zhang Yanhua, Qu Wenqing et al. Welding in the World[J], 2022, 66(7): 1447
- [9] Wang Xingxing, Li Zhenfeng, Gao Di et al. International Journal of Modern Physics B[J], 2022, 36(5): 2250045
- [10] Peng Rong(彭榕), Zhou Heping(周和平), Ning Xiaoshan(守晓山) et al. Journal of Inorganic Materials(无机材料学报)[J], 2002, 17(6): 1203
- [11] Han Lubin, Liang Lin, Chen Dedong et al. Microelectronics Reliability[J], 2020, 110: 113645
- [12] Andreas L, Gerhard S. *IEEE Transactions on Power Electronics*[J], 2007, 22(2): 384
- [13] Zhang Shibiao(张世镖), Li Jian(李健), Zhao Guohui(赵国惠) et al. Gold(黄金)[J], 2021, 42(3): 79
- [14] Zheng Jiachong(郑家翀). Uniform Electric Growth of Copper Pillar on Packaging Substrate and Application(封裝基板铜柱均 匀电生长及应用) [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2023
- [15] Ding Jiawen(丁家文). Study on Preparation and Properties of Nitride Ceramic Copper Cald Plate(氮化物陶瓷覆铜板的制备 及其性能的研究)[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2023
- [16] Lu Yanping, Zang Xiangrong, Du Bin. Materials Chemistry and Physics[J], 2021, 261: 124222
- [17] Wang Shuaichao(王帅超). Research on Active Brazing of Aluminum Nitride Ceramics and Copper(氮化铝陶瓷和铜的活 性钎焊研究) [D]. Changchun: Changchun University of Technology, 2022
- [18] Long Weimin(龙伟民), Zhang Lei(张 雷), Cheng Yafang(程亚 芳). MW Metal Forming(金属加工)[J], 2008, 12: 47
- [19] Chen Bo, Xiong Huaping, Cheng Yaoyong et al. Journal of Materials Science & Technology[J], 2015, 31(10): 1034
- [20] Lv Jinling(吕金玲). Research on Process and Brazing Mechanism for Joining AlN and Cu with Ag-Cu-Ti Based Composite Filler(Ag-Cu-Ti 基复合钎料连接AIN/Cu的工艺与 机理研究)[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2020
- [21] Zhang Xiaoyi(张笑一), Shang Hailong(尚海龙), Ma Bingyang
 (马冰洋) et al. Acta Metall Sinica(金属学报)[J], 2018, 54
 (4): 575
- [22] Zhao Bowen(赵博文), Shang Hailong(尚海龙), Chen Fan(陈凡) et al. Acta Physica Sinica(物理学报)[J], 2016, 65(8): 305
- [23] Su Zhoulin, Meng Qinglong, Zhang Bin. Optical Materials[J], 2016, 60: 443
- [24] Long Fei, He Peng, Sekulic D P. Metals[J], 2018, 8(5): 315
- [25] Long Fei, Zhang Guanxing, He Peng et al. Rare Metal Materials and Engineering[J], 2020, 49(2): 385

- [26] Long W M, Zhang G X, Zhang Q K et al. Scripta Materialia[J], 2016, 110: 41
- [27] Long Weimin, Li Shengnan, Du Dong et al. Rare Metal Materials and Engineering[J], 2019, 48(12): 3781
- [28] Long Weimin(龙伟民), Zhang Guanxing(张冠星), Zhang Qingke (张青科) et al. Transactions of the China Welding Institution(焊 接学报)[J], 2015, 36(11): 1
- [29] Long Weimin(龙伟民), Qiao Peixin(乔培新), Wang Haibin(王海滨) et al. Chinese Journal of Mechanical Engineering(机械工程学报)[J], 2001, 37(10): 107
- [30] Chen Dongdong, Qin Junhu, Gan Youwei et al. Rare Metal

Materials and Engineering[J], 2023, 52(2): 502

- [31] Wang Zitong, Dong Di, Xiong Ning et al. Rare Metal Materials and Engineering[J], 2024, 53(5): 1229
- [32] Cai Zhengxu(蔡正旭), Qi Yuefeng(齐岳峰), Zhang Guoqing(张 国清) et al. Welding & Joining(焊接)[J], 2017, (4): 29
- [33] Shang Yangeng(商延廣), Xu Feixia(许飞霞), Sun Daqian(孙大千) et al. Electronics Process Technology(电子工艺技术)[J], 2007, 28(1):10
- [34] Wang Huigai, Zhang Keke, Wang Bingying et al. Rare Metal Materials and Engineering[J], 2024, 53(6): 1523

On Low-Temperature Brazing of AlN Ceramics and Al: Design of Brazing Material, Microstructure and Properties of Joint

Zhou Hangze^{1,3}, Long Fei², Xu Rui^{1,3}, Wang Ce^{1,3}, He Peng^{1,3}, Shi Qingqing⁴, Zhao Yan⁵

(1. Zhengzhou Research Institute, Harbin Institute of Technology, Zhengzhou 450018, China)

(2. Institute of Materials, Henan Academy of Sciences, Zhengzhou 450046, China)

(3. State Key Laboratory of Precision Welding & Joining of Materials and Structures, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

(4. Gree Electric (Zhengzhou) Appliances Inc, Zhengzhou 450066, China)

(5. Wolong Electric Nanyang Explosion Protection Group Co., Ltd, Nanyang 473000, China)

Abstract: This study addresses the lack of brazing materials suitable for low-temperature brazing of AlN ceramics and Al. By adding elements In and Sn to AgCuTi brazing materials to lower their melting points, new low-temperature brazing materials Ag-28Cu-35In-2Ti and Sn-19Ag-14.35Cu-17.5In-1Ti were prepared to achieve good bonding of AlN/Al joints. The low-temperature brazing process, joint microstructure and properties of AlN ceramics and Al using two types of brazing materials were explored. Results show that for Sn-19Ag-14.35Cu-17.5In-1Ti brazing materials relatively stable compounds such as $InSn_3$ and Al_3Ti form at the solder joints. Ag-28Cu-35In-2Ti brazing material generates relatively stable compounds such as Al_2Cu , $AgIn_2$, and $TiAl_3$ at the solder joint, and the joint strength increases with the increase in welding temperature. To prevent the diffusion and precipitation of In, Ni plating is chosen on the surface of Al, but it reduces the thermal conductivity of the joint. It is found that using Ag-28Cu-35In-2Ti brazing material for welding contributes to the highest joint strength of 20.28 MPa at 640 °C for 30 min; under the condition of 620 °C for 15 min, the thermal diffusion coefficient can reach 65.941 m²/s. This brazing material provides a new method for highly reliable connection of AlN ceramics/Al.

Key words: low temperature brazing material; AlN/Al; microstructure and properties; surface modification

Corresponding author: He Peng, Ph. D., Professor, State Key Laboratory of Precision Welding & Joining of Materials and Structures, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, P. R. China, E-mail: hithepeng@hit.edu.cn